

“基 条件与 大 学仪器 备 发”
点专 2024 年度 申报指南
(征求意见稿)

()
采 : , ,
、 备 办 、
、 部 , 、
、 步 , 、
、 。
标: 1500Da ~ 10000Da, ≤
2(m/z), ≤ 20nmol/L, ≤ 1ng,
标 ≥ 50, ≥ 99.7%,
≥ 3000 本。
≥ 3000 , 不 8 ,
、 安 、 、 2
。 报 ≥ 10 , 、 、 、 、

标 ≥ 2 , ≥ 3 ,
 。
 ()
 : 白、白、
 、 mRNA、 DNA、
 、
 部、
 、 部
 、
 、
 。
 标: 8,000,000Da(比 80,000);
 辨 $\geq 50,000$, 辨 , 100
 埃 辨 ≥ 70 , $\leq 10\text{nmol/L}$, \leq
 10%RSD。
 ≥ 3000 , 不 8 ,
 、 、 2 。 报
 ≥ 10 , 、 、 、 标 \geq
 2 , ≥ 3 , 。
 (,
 部)
 : / 、

别

部

标： 泵 $\geq 50\text{Mpa}$ ， $0.001 \sim$
 $5\text{mL}/\text{min}$ ， $\leq 0.05 \% \text{RSD}$ ， $\leq 0.1\mu\text{g}/\text{L}$ (Cl^-)，
 $\leq 3\%$ (180)， ≥ 1.7 ()，
)， $\leq 0.2\text{nS}/\text{cm}$ ， $\leq 2\mu\text{S}/30\text{min}$ ，
 $\geq 200\mu\text{eq}$ ， $0-10\text{mL}/\text{min}$ ，
 $0.01\mu\text{S}/\text{cm} - 2\text{mS}/\text{cm}$ ， 辨 $\leq 0.001\mu\text{S}/\text{cm}$ ，
)， $\geq 99\%$ ， ≥ 720 。

≥ 3000 ， 不 8 ，
 2 。 报 ≥ 10 ，
标 ≥ 2 ， ≥ 3

辨 ()

: 胞、 病

胞

部 辨 ， ， ， 。

标: : $\geq 30\mu\text{m}$, $\geq 10\mu\text{m}$, $\leq 2\text{nm}$, ≥ 3 ；

胞 : $\geq 100\mu\text{m}$, $\geq 50\mu\text{m}$, 辨 $\leq 200\text{nm}$, 辨 $\leq 250\text{nm}$, ≥ 3 , $\leq 0.5\text{s}$ 。

≥ 3000 , 不 8 , 胞 、 、 2 。 报 ≥ 10 , 、 、 标 ≥ 2 , ≥ 3 , , 。

() 参 : 、 、 参 、 、 参 步 , 、 部 , , 。

标: $\geq 300\text{mm}\times 300\text{mm}$, $\geq 100\mu\text{m}\times 100\mu\text{m}$ (0.95NA) , 表 辨 $\leq 10\text{nm}$, 辨 $\leq 350\text{nm}\times 500\text{nm}\times 50\text{nm}$, $\geq 150\text{cm}^{-1}$,

辨 $\leq 1.0\text{cm}^{-1}$ (785nm, 1200gr/mm), 波 $\leq 0.1\text{cm}^{-1}$,

辨 $\leq 350\text{nm}\times 500\text{nm}\times 1000\text{nm}$,

≥ 2800 / (Si), 采 ≥ 400 ,

辨 $\leq 10\text{Mpa}$ (Si100)。

, ≥ 3000 , 不 8
, 半 材 2 。 报
 ≥ 10 , 、 、 、 标
 ≥ 2 , ≥ 3 , ,
。

()
: 变 、
标 辨 , 百
、 辨 、
、 、
、 、
部 ,
、 ,
。

标: 辨 $\leq 200\text{ps}$; 辨 $\geq 40\text{lp/mm}$,
 $\geq 10\text{mm}\times 8\text{mm}$; 200nm-850nm,
 $\geq 20\%$; $\leq 35\text{ps}$;

， MTBF ≥ 3000 h。

， ≥ 3000 ， 不
 8 ， 变 、 材
 2 。 报 ≥ 10 ， 、
 、 、 、 标 ≥ 2 ， ≥ 3
 ， ， 。
 斑 ()
 : 斑 、 参
 ， 斑
 备、 — 补 、 斑
 ， 、
 、 部 斑 ，
 ， 。
 标: 30 ~ 25000W， 波 400 ~ 1700nm，
 100 ~ 3000 μ m， ≥ 10 MW/cm² (1070nm、
 5kW)、 ≥ 6 MW/cm²(1070nm、 20kW)， ≤ 200 rad，
 xy ≥ 8 mm \times 8mm， z ≥ 120 mm，
 ≥ 7500 rpm， 辨 $\leq 32 \times 32 \sim$
 1024 \times 1024。
 ≥ 3000 ， 不 8 ，
 、 、 备 2 。 报

≥ 10 , 、 、 、 、 标 ≥ 2
 , ≥ 3 , , 。
 参 (,
 部 |)
 : 、 、
 、 、
 , 波 、 、
 、 、 、 、
 、 部 参
 , , 。
 标: 440nm-1650nm不 波 ,
 $\leq 20\text{kHz}$, $\leq -115\text{dB/Hz}$ (200kHz) ,
 $\geq 25\text{kHz}$; $\geq 3\text{Kd}$ () $\geq 150\text{m}$
 () , 辨 $\leq 0.5\text{m}$, \leq
 0.03K , $\leq 0.005\%$; $\geq 1\text{km}$,
 辨 $\leq 50\text{m}$, $\leq 1\%$, $\leq 0.5\%$,
 $\leq 0.5\text{m/s}$ 。
 , ≥ 3000 , 不 8
 , 、 、 、 、
 2 。 报 ≥ 10 , 、
 、 、 、 标 ≥ 2 , ≥ 3



参

,

边

标

采

,

,

， 。 ()

： 备

， 、 辨

补 、 、 、

部 ， 、 、

，

标： 100 ， \leq

0.1 ， ： 0 1mm， $\leq 10\mu\text{m}$ ，

0 3mm， 辨 $\leq 80\text{nm}$ ，

$\geq 80\%$ ，

$\geq 90\%$ ； $\leq 0.1\mu\text{m}$ ，

$\leq 0.1\mu\text{m}$ ， 摆 ≤ 0.1 ， $\geq 2000\text{kg}$ ， 1m

$\leq 2\mu\text{m}$ ， $\leq 8\mu\text{m}$ ， $\leq 8\mu\text{m}$ ，

$\geq 1000\text{mm}$ ， $\geq 2000\text{mm}$ ， \geq

1600mm。 ， \geq

3000 ， 不 8 ， 、

、 2 。 报 ≥ 10 ，

、 、 、 、 标 ≥ 2 ，

≥ 3 ， ， 。

()

： 本 布 、 布

辨 ， 布

、 、 辨 、

、 部 ，

、 。

标： $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ ， 辨 $\leq 80\mu\text{m}$ ，

$\leq 1\mu\text{m}$ ， $\geq 1\text{T}$ ，

$\geq 0.5\text{T}$ ， $\leq 1.5\text{pT}/\text{Hz}^{1/2}$ ，

$\leq 1.0 \times 10^{-14} \text{Am}^2$ ， $\leq 2^\circ$ 。

、 ≥ 3000 ，

不 8 ， 、 材 2

。 报 ≥ 10 ， 、 、 、

、 标 ≥ 2 ， ≥ 3 ，

、 。

()

： 5G

、 并 、

、 5G 、 并

、 5G 布 部 、 5G

安、5G

部

5G

标: | 5G 1

$\geq 200\text{Gbps}$, 5GC

、IMS

5G 1 并 ≥ 1000

≥ 10000 ≥ 60000

5G 安 1

1 5G

备 5

1000 不 8

、变操案 2

报 ≥ 8

、标 ≥ 3 ≥ 4

半 参 ()

: SiC、GaN IGBT 半 参
 , kV/kA 、
 、 参 表 、 半
 别 , 、
 部 半 参
 ,
 。
 标: -1000A ~ +1000A, 辨
 10fA, -3000V ~ +3000V, 辨 2μV,
 15kW, 1kHz ~ 5MHz,
 辨 10mHz, 10μs, 辨
 1μ 。
 ≥ 3000 , 不 8 ,
 、 、 备、 备 2
 。 报 ≥ 10 , 、 、 、 、
 标 ≥ 2 , ≥ 3 ,
 。
 ()
 : 、
 、 背 、
 标 - - - 、 部

布 布 、 辨 步采

， 、 、 部

， ，

。

标： 参 $-10\text{mV/m} \sim +10\text{mV/m}$ ， 辨 $\leq 10\text{nV}$ ， $\geq \text{DC}-3\text{kHz}$ ； 参 $-100\mu\text{T} \sim +100\mu\text{T}$ ， 辨 $\leq 0.1\text{nT}$ ， $\geq \text{DC}-3\text{kHz}$ ； 参 $110\text{dB} \sim 170\text{dB}$ ， $\leq \pm 3\text{dB}$ ， $\geq 2\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ ； 辨 $\leq 10\text{Pa}$ ， $\geq \text{DC}-0.5\text{Hz}$ ； -15dB 比 - -

- 参 ， 部 $\geq 10\text{km/h}$ ，

6 。

≥ 3000 ， 不 8 ，

标 、 、 2

。 报 ≥ 10 ， 、 、 、 、

标 ≥ 2 ， ≥ 3 ， ，

。

()

： 表 、

， 、 、

、 、

部

标: (He4) $\leq 2\text{K}$, (He3)

$\leq 500\text{mK}$, $\leq \pm 1\text{mK}$, \leq

100pm/h, $\leq 50\text{pm/h}$, $\leq 2\text{pm}$,

$\leq 2\text{pA}$, ≥ 5 ,

9T, $\geq 1.5\mu\text{m} \times 1.5\mu\text{m} \times 0.4\mu\text{m}$,

$\leq 50\text{pm}$, $Q \geq 50000$ 。

3000, 不 8, 表

、半 材 2。 报

≥ 10 , 标

≥ 2 , ≥ 3 。

部

()

:

参

部

标:

1kV ~ 10kV ， 斑 ≤ 100nm，
 ≤ 10mA/cm²@100nm， ≥ 100 。
 ，
 ≥ 5000 ， 9 ，
 薄 、 2 。 报 ≥ 3 ，
 、 、 、 、 标 ≥ 1 ，
 ， 。
 ()
 : ， 材
 、 CMOS ，
 部 ，
 。
 标: ≥ 2048×2048， ≤ 10μm，
 1:1， MTF ≥ 0.2 (1/2Nyquist) ， 120kV 材
 比 ≥ 3:1， ≥ 30fps， ≤ 30
 3×3 。
 ≥ 5000 ， 9 ，
 120kV 2 。 报
 ≥ 3 ， 、 、 、 、 标
 ≥ 1 ， ， 。
 ()

辨、辨
 (TDC)
 部
 标: $\geq 20\text{mm}$, 边 $\leq 2\text{mm}$,
 $\geq 8 \times 8$, 辨 $\leq 5\text{mm}$,
 辨 $\leq 2\text{mm}$, TDC 辨 (FWHM) $\leq 10\text{ps}$,
 jitter $\leq 5\text{ps}$, 辨 (FWHM) $\leq 100\text{ps}$.
 ≥ 5000 , 9,
 PET 部PET 2。报 ≥ 3 ,
 标 ≥ 1 ,
 ()
 : ^3He ,
 备、
 部,
 部,
 部,
 标: $\geq 70\%$ (4\AA), 辨 $\leq 1\text{mm}$,

$\leq 1\mu\text{s}$, $\geq 1\text{m}^2$, \leq
 $1/10^6$. ,
 ≥ 5000 , 9 , 安
2 。 报 ≥ 3 ,
、 、 、 、 标 ≥ 1 ,
, 。 ()
: ,
材 备、 备、
, ,
部 , ,
。 。
标: 2ppb ~ 500ppm,
0ppm ~ 10ppm, : $\pm 1\%$ $\pm 1\%$
() , 0 ~ 50 , 0bar ~ 100bar。
, ,
 ≥ 5000 , 9 , ,
2 。 报 ≥ 3 , ,
、 、 、 标 ≥ 1 , ,
。 ()

、暗、部、

部、

。 标: $\geq 600\text{nm} \sim 900\text{nm}$, $\geq 2000 \times 256$, $\leq 15\mu\text{m} \times 15\mu\text{m}$, 采 $\geq 30\text{Hz}$, $\geq 80\%$; ≤ -80 , 暗 $\leq 0.001\text{e-}/\text{pixel}/\text{sec}$; $\leq 3\text{e- (rms)}$, $\geq 30000\text{e-}$.

, ≥ 5000 , 9, 2。报 ≥ 3 , 标 ≥ 1 , ()

采部, 部, 标: 参 9mm , $0.01\text{mm} \sim 1.0\text{mm}$, $\leq \pm 0.3\mu\text{m}$, 辨 $\leq 0.01\mu\text{m}$, $\geq 10\text{Hz}$. ≥ 5000 ,

部，

标：波 $\geq 450\text{nm} \sim 1700\text{nm}$ ， \geq

100kHz， $\leq 5\mu\text{m}$ ， $\geq 800 \times 600$ ，

$\geq \pm 12^\circ$ ()。

≥ 5000 ，

9， 2。报 ≥ 3 ， 标 ≥ 1

波 ()

波，

波波，

部，

标：波 $\leq 2\text{GHz}$ (3dB)， $\leq 3.5\text{dB}$ ，

波 $\geq 1\text{nm}$ ，波 $\leq 100\mu\text{s/nm}$ ，波波

$\leq 1\text{pm/}$ 。

≥ 5000 ， 9，

波 2。报 ≥ 3 ，

标 ≥ 1 ，

()

>

表

部

标:

0.01mL/min ~ 10mL/min;

nA ~ 500mA,

, m ≥ 1nA, 比 ≥ 0.1nA, 0

)

≥ 1ps,

辨 ≤ 1μm,

南京航空航天大学

料

料

料

料 料

$1\text{cm} \times 1\text{cm}$ ≥ 2 $\text{m} \times 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 备
 本、, 4 ~ 40 备仓、
 ; 本
 标 ≤ 5 ; $\geq 1.5\text{cm}$, 本
 $\geq 90\%$,
 ≥ 5000 , 9 , 辨
 、 2 。 报 ≥ 3 ,
 、 、 、 、 标 ≥ 1 ,
 , 。
 ()
 : ,
 、 辨 、
 ,
 部 ,
 , 。
 采 标: , $\leq 30\text{nm}$,
 $\geq 50\mu\text{m}$, $\leq 1\text{L}/\text{min}$,
 辨 $\leq 1\mu\text{m}$,
 ≥ 5000 , 9 ,
 、

标 ≥ 1 ， ， 。
 ()
 : ， ，
 、 、 、 ，
 、 部 ，
 ， 。
 标: 材 : 、 ，
 材 : ； $\geq 200\text{mm}$, 波 193nm、248nm,
 ($1\mu\text{m} \leq \leq 1\text{mm}$) 1nm (rms) ,
 ($\leq 1\mu\text{m}$) 0.5nm (rms) , 98% (248nm) ,
 97.5% (193nm) 。
 ， ≥ 5000 ， 9 ，
 备 、 备
 2 。 报 ≥ 3 ， 、 、 、
 、 标 ≥ 1 ， ， 。
 材 ()
 : / 、 、 、
 材 备 、 备 、 胺、
 、 胺、 苯 、 苯并

备, 备
, 备,
保、 材不

。 标: 20
(材 备 $\geq 99.9\%$, $\leq 100\text{ppm}$;
材 备 $\geq 99\%$, $\leq 10\text{ppm}$;
材 备 $\geq 98\%$, \leq
100ppm) 备, 5-10 百 /
备。 备 -130 oC~+500 oC
, 40GHz
0.003, 500 oC。

报, 不 20, 标 5-10,
标 不 2。

病
| 标 ()
: X / CT、
病、 标
标, 辨 安 X
/ CT 标。

靶、胞，
 X / CT
 表 材 标 / 标 / ， 并
 标。
 标： 2~3 (癌、 癌、
 癌) X / CT ， 不
 () ，
 Z ； 2~3
 CT 病 (、 、
) ； 1 Z CT ， 并
 (100L) ， 标 3
 ， 标 不 3 ； 并 报
 1~2 ； X / CT 参
 ≤ 0.5% ， CT CT 备 。

病
 ()
 : ， 采 编 、
 胞 、 ，
 、 病 病

病 。 病 病

。 表 、 病 。

， 靶: 5 ~ 10 /

病 。 病 2 表

标, (保 >80%)。

病 不 30 (包 、 病 、 表 、 表)

、 2 ~ 3 / 病 。

靶 病 。

本 。

不 3 ， 并

。

安 编

标 ()

: 、

癌 、 安 “ 脖 ” ， 编

胞 靶 。
 、 贝 、 表
 表 。 采 、
 、 癌
 。 参
 背 表 。
 本 。
 。
 标： 2~3 癌 、
 安
 、 贝 、 表 、 。
 3 (6~8 、 19~21 、 32~34)
 参 20 (标不 15 /按 别)。
 600 标 。
 (The International Council for
 Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for
 Human Use, ICH) S1B 癌 , 5~6
 , 1 比 。
 (Oral polio vaccine, OPV) ,
 不 2 , 并
 比 。 2~3 。

本，并
保
：
，
， 标
安
安
CNAS
标： 不 20 20
(/ 、 、
) 、 、 不 1000
， 5
， 安
报。 不 10 病
。 不 10 编
安 不 20
CNAS
报。

材 ()

材 :

(、补) (、) ,

参 材

材 , 材

材 , 备材

材 , 并

标:

比 2倍 , 包 3 ,

材 2 ;

材 2 ,

≥90% ; 、 、 不

材 , 包 不 5

材 不 15 ; 3 5

材 , 2

10 ;

。 草 ()

：“ ” 背 ，

草 ， 草 、 草 、 草 ；

草 草 表 参 ，

草 ； 草

、 被 ， 草

“ 北”

。 标： 草 1 ，

包 、 不 4

， 不 1000 GPU ， 并 不 30%；

草 1 ， 包 8 ， (

，)、 (，)、 (，

表 ， ，) 不 8

， 辨 不 1km; 草
 1 ， 表 草 包
 、 草 不 10 ，
 75% ； 草
 1 ， 不 3 ， 不 300 (、
 草) 不 150 ；
 部 ， 并 ， “
 北” ， ， ， ，
 不 5 。
) ()
 :
 ， ， ， ，
 、 、 、 、 ， 标 、
 ;
 、 ， AI-Ready 、
 辨 ;
 ， 、
 ; ；
 ， - -

， 部 并 。

标: -

1 ， () 边 、

备 ， ≥ 10000 / ，

， 边 ≤ 120 ；

1

南京航空航天大学 A000551

表 变 胞 , 并 、 ,
病靶 、 胞
。

标:
并 5 哺 10
胞 、 百 、 百 表 、
、 5PB, 、 标 、
、 ; 1
、 3
5 并
(不 3)
10% ; 1 参 , 2
胞 、
胞 , 不 6
(标 布
) , 不 表 胞
表 , (≥ 2) 胞 表
变 20%;
3
20%, 10 病 胞

， 不 20 胞 、 100
， 70%， 胞
、 、 表 ， 胞 、
胞 病 变 不 3 胞表
， 表 靶 50%， 并 不
3

南京航空航天大学 A000555